



# Закрытое акционерное общество «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

**Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы**

**2Т630 9**

*Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы 2Т630А9, 2Т630Б9 в металлокерамическом корпусе 4601.3-1, предназначенные для работы в ключевых, линейных и других схемах аппаратуры специального назначения.*

Схема расположения выводов (площадок)

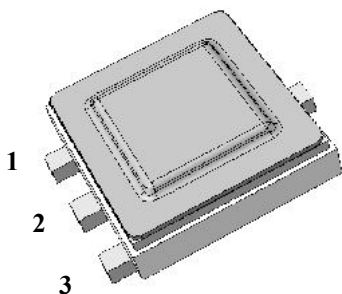


Схема расположения выводов	Назначение
1	База
2	Коллектор
3	Эмиттер

Основные электрические параметры при  $T_{окр.}=(25\pm 10)^{\circ}C$

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма			
		2Т630А9		2Т630Б9	
		не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА ( $U_{кэ} = 90В, R_{бэ} \leq 3 кОм$ )	$I_{кэР}$		1		1
Обратный ток эмиттера, мкА ( $U_{эб} = 5 В$ )	$I_{эбо}$		0,1		0,1
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{кэ} = 10 В, I_{к} = 150 мА$ )	$h_{21э}$	40	120	80	240
Граничное напряжение, В ( $I_{к} = 30 мА, t_{и} \leq 100 мкс, Q \geq 200$ )	$U_{кэогр}$	90		80	
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер, В ( $I_{к} = 150 мА, I_{б} = 15 мА$ )	$U_{кэнас}$		0,3		0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ( $I_{к} = 150 мА, I_{б} = 15 мА$ )	$U_{бэнас}$		1,1		1,1
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В ( $R_{бэ} = 3 кОм, I_{к} = 100 мкА$ )	$U_{кэР проб}$	120		120	
Пробивное напряжение эмиттер-база, В ( $I_{э} = 100 мкА$ )	$U_{эбопроб}$	7		7	
Рассеиваемая мощность на коллектор, Вт	$P_{к}$			0,2	